L-57

# 誘電体と導体が混合した物体による電磁波の散乱

Scattering of Electromagnetic Wave by Object of Mixed Perfectly Conductor and Dielectric

○岸田航<sup>1</sup>,藤井健太<sup>2</sup>,尾崎亮介<sup>3</sup>,山﨑恒樹<sup>3</sup>

\*Kishida Wataru<sup>1</sup>,Fujii Kenta<sup>2</sup>,Ryosuke Ozaki<sup>3</sup>,Tsuneki Yamasaki<sup>3</sup>

Abstract: In this paper, we proposed an atomic model method for the scattering of electromagnetic waves by a conducting rectangular cylinder with the thickness of dielectric constant. The difference with the conventional method, such as a method of moments(MoM) and finite element method(FEM), are as follows: (1)The causality which is the electric field made with a wave source besides the atom when it is exciting, is clear, (2)It does not appear at the singular points like singular integral equations,(3) The area which can be applied can cover the wide range from a dielectric to a perfect conductor, and (4)The diagonal element of the simultaneous equation is effects of atomism for information on the inhomogeneous structure both the dielectric and the conductor.

## 1. はじめに

近年,導体と誘電体が混合した任意形状物体の散乱 問題が注目され FDTD 法等色々な解法で数値結果が報 告されている.アトム法は散乱体の分極に着目した解 法で混合物体の解析に有力な解法の一つである.

本文ではアトム法を用いて導体と誘電体が混合した 角柱物体の散乱問題を解析し、アトム半径が散乱特性 に及ぼす影響を検討した.

## 2. 解析方法

Fig.1に示すように導体と誘電体( $\varepsilon_m$ )の混合された角柱 物体(断面:  $2a \times c$ )は y 方向に一様で内部に誘電体 (-b/2 < x < b/2)と導体(|x| > b/2)を持つ構造である. この問題をアトム法で解析する場合にFig.2のように2 次元アトム(半径 $r_a$ )を配置して任意形状の散乱体を形 成する.

入射波はz方向成分の電界を持つTE波で  $E_z^{(i)} = E_0 e^{-jk(x\cos\phi + y\sin\phi)}$  (1) となる.ただし、 $\phi$ は入射角である.

アトム法では、Fig.2の円で示したアトムは間隔 $\Delta l$ の 正方晶系の中に納まっている.アトムの総数を2N+1する.ここで任意の位置にある第nアトムを考える. 第nアトムにおける電磁界 $E_n$ は、入射波 $E_n^{(i)}$ とn以外 のアトムが作る電磁界となり次式で表される.

$$E_n = E_n^{(i)} + \sum_{m=1, m \neq n}^{2N+1} A_m H_0^{(1)} \left( k_0 r_{m,n} \right)$$
(2)

ただし,  $k_0 = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ ,  $H_0^{(1)}(r)$ は 0 次の第一種 Hankel 関数,  $A_m$ は第*m* アトムの励振強度である.

 $r_{m,n}$ は第mアトムから第nアトムまでの距離であり 第nアトムの位置を $x_n, y_n$ と書くと次式となる.

$$r_{m,n} = \sqrt{(x_m - x_n)^2 + (y_m - y_n)^2}$$
(3).

次に第nアトムの励振強度 $A_n$ と作用する電界 $E_n$ の 比をアトムインピーダンス $Z_n$ とすると、式(2)は次式と なる.









$$Z_n A_n = E_n^{(i)} + \sum_{m=1, m \neq n}^{2N+1} A_m H_0^{(1)} \left( k_0 r_{m,n} \right)$$
(4)

$$Z_{n} = \frac{E_{n}}{A_{n}} = \frac{k_{0}r_{a}H_{1}^{(1)}(k_{0}r_{a})J_{0}(k_{m}r_{a}) - k_{m}r_{a}H_{0}^{(1)}(k_{0}r_{a})J_{1}(k_{m}r_{a})}{k_{m}r_{a}J_{0}(k_{0}r_{a})J_{1}(k_{m}r_{a}) - k_{0}r_{a}J_{1}(k_{0}r_{a})J_{0}(k_{m}r_{a})}$$
(5)

式(4)をマトリクス表示すると次式の連立方程式が得られる.

$$\begin{bmatrix} C_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_m \end{bmatrix} = -E_n^{(i)} \tag{6}$$

$$C_{mn} = (1 - \delta_{mn}) H_0^{(1)} (k_0 r_{mn}) - \delta_{mn} Z_n$$
(7)

ただし,
$$\delta_{\scriptscriptstyle mn}$$
はクロネッカーのデルタである.式(6)で

1:日大理工・院(前)・電気2:株式会社アルメックス3:日大理工・教員・電気

求められた $A_m$ を用いて散乱波 $E_z^{(s)}$ は次式となる.

$$E_{z}^{(s)} = \sum_{m=1}^{2N+1} A_{m} H_{0}^{(1)}(kr)$$
(8)

ここでrは $(x_n, y_n)$ にあるアトムと(x, y)観測点Pとの

距離である.式(8)を遠方界の定義(
$$r \to \infty$$
)より  

$$\lim_{r \to \infty} E_{z}^{(s)} = \sqrt{\frac{2}{\pi k r}} f(\theta) e^{j\left(kr - \frac{\pi}{4}\right)}$$
(9)

となる.よって散乱振幅は次式となる.

$$\left|f\left(\theta\right)\right| = \left|\sum_{n=1}^{2N+1} A_n e^{-jk_0\left(x_n\cos(\theta) + y_n\sin(\theta)\right)}\right|$$
(10)

## 3. 数值結果

Fig.3 はモード数 N を固定し $R_a$ に対する散乱振幅 | $F(\theta)$ |の収束である. Fig.3 より次のことがわかる.

(1)  $R_a$ を小さくすると徐々に散乱振幅が下がり0付近で急激に値が変化している.  $R_a$ を小さくしすぎると収束が悪くなる.

(2)  $R_a = 0.4$  付近でグラフが交差するので $R_a = 0.4$ を用いて解析を行えばNの値に依存せず近い結果を得られると考えられる.

Fig.4 は $x = -a/2 \le a/2$ がすべて完全導体(C = 0の場合)とし、解析した誘電体(b/a = 0.5,  $\varepsilon_m/\varepsilon_0 = 5$ )の収束である. Fig.4 より次のことがわかる.

(1)誘電体の場合, N = 1000以上で一定の値に収束する.また,導体の場合と同様に $r_a = \Delta l/4$ の収束が早い. Fig.5(b)は2枚のストリップ導体を持つ平行平板の場合

( $R_a = 0.4 \ge \log b/a = 0.5$ , c/a = 0.1)の散乱問題 を解析した結果である. Fig.5(a)の①は導体が真空の場 合,②は内部に誘電体を装荷した場合,③上部の導体 を取り除き,その内部に誘電体を装荷した場合であ る.Fig.5(b)より次のことがわかる.

- 主ローブ(入射角135°付近)では③>②>①の順 で散乱波は見大きくなる.
- (2) サイドローブ(入射角150°付近)では、③>①>
   ②の順で散乱波が大きくなる.
- (3) 形状の影響は、入射角 0°~60° で現れてくる.

#### 4. まとめ

本文では導体と誘電体の混合モデルの解析を行い, TE 波入射の散乱パターンを解析した.数値解析によりアトム半径 R<sub>a</sub> の変化による散乱振幅の精度を検討し,今回のモデルに適した R<sub>a</sub> を示した.今後は TM 波の解析を行う予定である.

## 参考文献

細野,細野, "アトムモデルによる散乱解析" 信学論
 (C), Vol.J83-C, No.9, pp.812-818(2000).

[2]山崎,日向,細野, "ストリップ導体による電磁波の散 乱"電学論(A),Vol.113-A,No.3, pp.176-184(1993)



Fig.5(a)Scattering model,(b)Scattering pattern

[3]Yamasaki: "Scattering of Electromagnetic Wave by a Conducting RectangularCylinder with the Thickness of Dielectric Constant", AT-RASC2015.